

InGaAs фотодетекторный чип 2200 нм, 1000 мкм — техническое описание

P/N : WIR4-1000

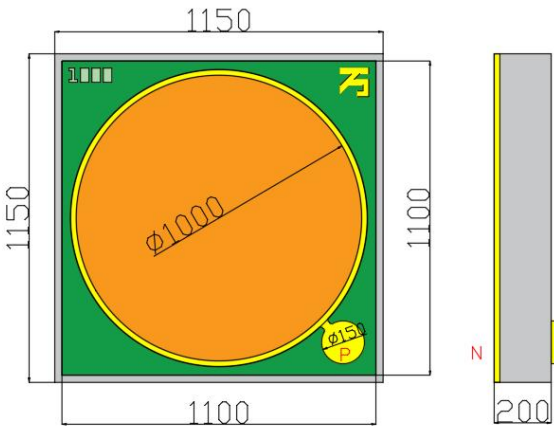
Применение

Оптические датчики; датчики CO2; измерители оптической мощности; спектральная чувствительность 900–2200 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.

N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	995	1000	1005	мкм
Ширина чипа	1130	1150	1170	мкм
Длина чипа	1130	1150	1170	мкм
Высота чипа	180	200	220	мкм
Размер контактной площадки	140	150	160	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-0.5V			9	мкА
Чувствительность	R	Vr=0V,@2000 nm	1.0	1.2	-	А/Вт
Емкость	Cp	Vr=0V, f=1MHz		440	1000	пФ
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	2004	2200	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА